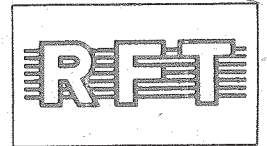


Information



SY 526

2/86

vorläufige technische Daten

Hersteller: VEB Mikroelektronik „Robert Harnau“ Großräschen

Schottky-Leistungsgleichrichterdiode im Metallgehäuse (Schottky-Barrier-Diode)

1. Abmessungen in mm und Anschlußbelegung

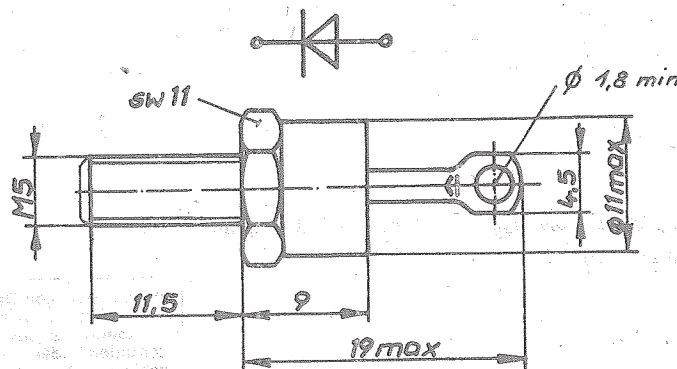


Bild 1: Abmessungen und Anschlußbelegung

Masse ca. 8 g

TGL 43 351

2. Grenzkennwerte

Typ	U_{RRM}	U_{RWM}	Einheit
SY 526/0,3	30	30	V
SY 526/0,35	35	35	V
SY 526/0,4	40	40	V
SY 526/0,45	45	45	V

	Kurzzeichen	Wert	Einheit
Effektiver Durchlaßstrom	$I_F(RMS)$	39	A
Mittlerer Durchlaßstrom 1)	$I_F(AV)$	25	A
Stoßstrom 2)	I_{FSM}	500	A
Sperrschichttemperaturbereich	ϑ_j	-55 ... +150	$^{\circ}C$
Lagertemperaturbereich	ϑ_{stg}	-55 ... + 55	$^{\circ}C$
Betriebstemperaturbereich	ϑ_a	-55 ... +125	$^{\circ}C$

3. Kenngrößen

	Kurzzeichen	Wert	Einheit
Durchlaßspannung 3)	U_{FM}	0,55	V
periodischer Spitzensperrstrom 4)	I_{RRM}	3	mA
periodischer Spitzensperrstrom 5)	I_{RRM}	200	mA
Spannungsanstiegsgeschwindigkeit	du_R/dt	1000	V/ μ s
Gesamtkapazität (typ) 6)	C_{tot}	3	nF
Innerer Wärmewiderstand	R_{thjc}	$\leq 1,6$	K/W

1) $\vartheta_j = 150^{\circ}C$; sinusförmiger Stromverlauf

2) 50 Hz-Sinushalbwellen; $t_p = 10$ ms; $\vartheta_c = 25^{\circ}C - 5K$

3) $I_{FM} = 25$ A; $\vartheta_c = 25^{\circ}C - 5K$

4) $U_R = U_{RRM}$; $\vartheta_c = 25^{\circ}C - 5K$

5) $U_R = U_{RRM}$; $\vartheta_c = 100^{\circ}C - 5K$

6) $U_R = 5$ V; $f = 100$ kHz

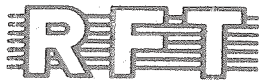
Bestellbezeichnung:

Schottky-Leistungsgleichrichterdiode vom Typ SY 526/0,3 mit einem Grenzwert der periodischen Spitzensperrspannung von 30 V

Änderung vorbehalten!

Ausgabe März 1986

Die vorliegenden Datenblätter dienen ausschließlich der Information! Es können daraus keine Liefermöglichkeiten oder Produktionsverbindlichkeiten abgeleitet werden. Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts sind vorbehalten.



Herausgeber

vab applikationszentrum elektronik berlin
im vab kombinat mikroelektronik

Mainzer Straße 25

Berlin 1035

Telefon: 5 80 05 21, Telex: 011 2981; 011 3055